



主要用途

高压开关、功放。

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg}	——贮存温度.....	-55~150
T_j	——结温.....	150
P_C	——集电极功率耗散 ($T_c=25$).....	25W
V_{CBO}	——集电极—基极电压.....	-180V
V_{CEO}	——集电极—发射极电压.....	-160V
V_{EBO}	——发射极—基极电压.....	-6V
I_C	——集电极电流.....	-1.5A
I_{CP}	——集电极峰值电流.....	-3A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I_{EBO}	集电极—基极截止电流			-10	μA	$V_{EB}=-4V, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—发射极饱和电流			-10	μA	$V_{CB}=-120V, I_E=0$
HFE	直流电流增益	60		200		$V_{CE}=-5V, I_C=-300mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降		-0.5	-1.0	V	$I_C=-500mA, I_B=-50mA$
V_{BE}	基极—发射极导通电压			-1.5	V	$V_{CE}=-5V, I_C=-10mA$
f_T	特征频率		100		MHz	$V_{CE}=-10V, I_C=-50mA$
C_{ob}	共基极输出电容		30		PF	$V_{CB}=-10V, f=1MHz$
B_{VCBO}	集电极—基极击穿电压	-180			V	$I_{CB}=-1mA, I_E=0$
B_{VCEO}	集电极—发射极击穿电压	-160			V	$I_{CE}=-1mA$
B_{VEBO}	发射极—基极击穿电压	-6			V	$I_{EB}=-1mA, I_C=0$
t_{on}	启动时间	0.29			μsec	
t_f	关闭时间	0.19			μsec	
t_{stg}	储存时间	0.48			μsec	

HFE 分档及其标志

D

E

60—120

100—200

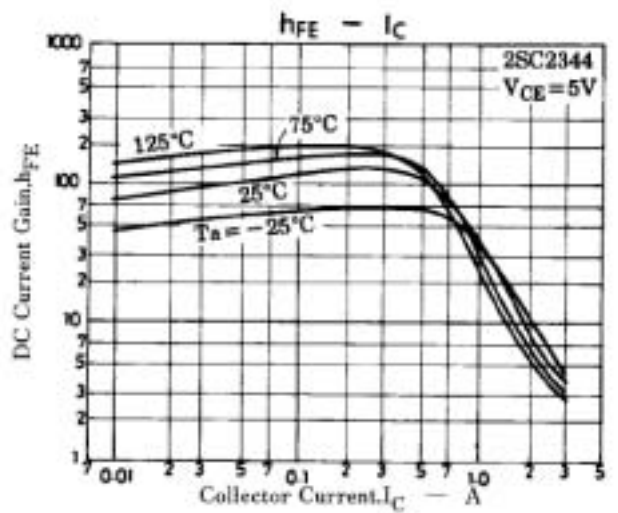
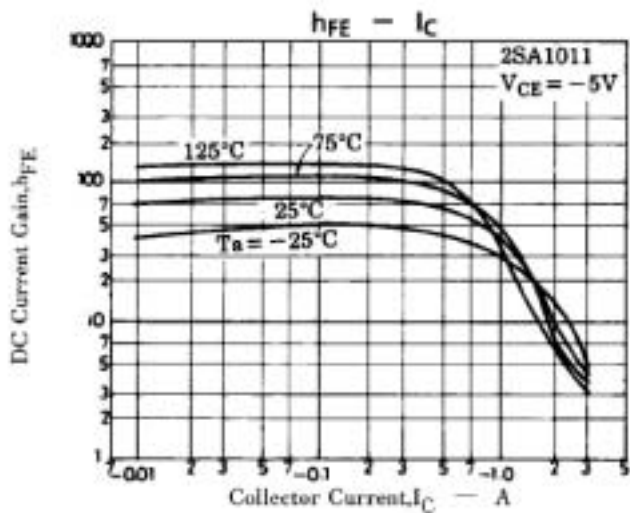
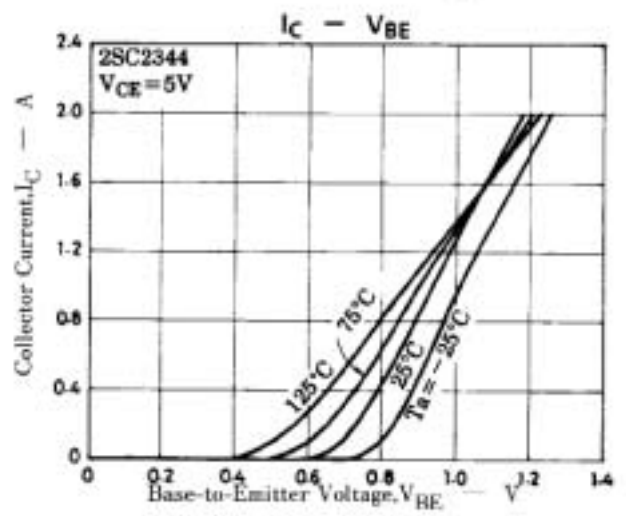
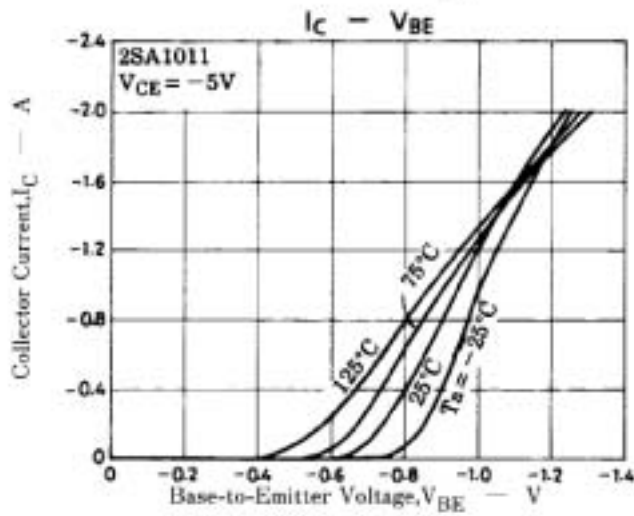
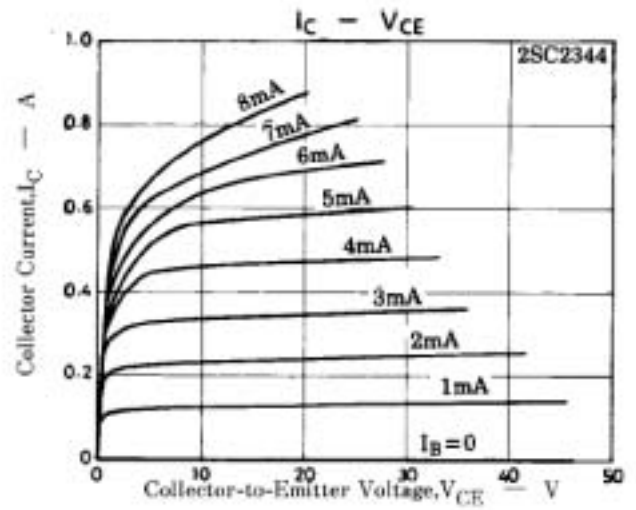
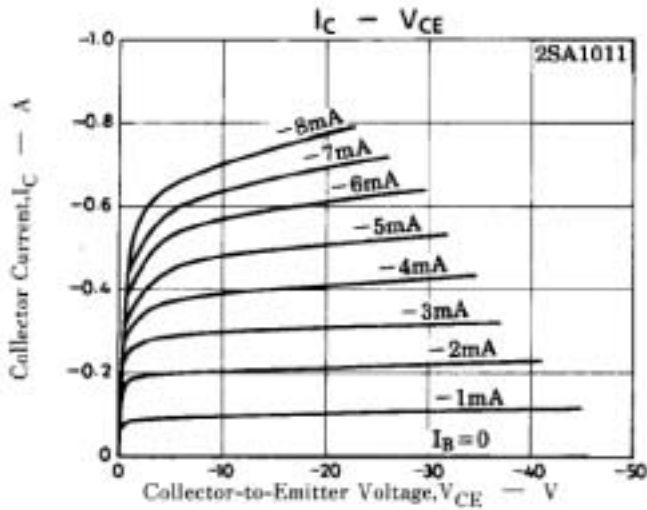


汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HA1011

对应国外型号
2SA1011





汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HA1011

对应国外型号
2SA1011

